

## **The Data Book Project**

DatasheetArchive.com has launched an ambitious effort to digitize thousands of obsolete data books and technical manuals, making them searchable via the DatasheetArchive website.

**Scroll down to see the scanned document.**

# FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS :

**最新トランジスタ規格表** (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T <sub>b</sub> =25°C)					電気的特性 (T <sub>b</sub> =25°C)										外形	備考
				V <sub>ceo</sub> (V)	V <sub>ceo</sub> (V)	I <sub>c</sub> (mA)	P <sub>c</sub> (mW)	T <sub>j</sub> (°C)	I <sub>ceo</sub> 最大値 (μA)	直流又はパルスI <sub>BE</sub>		バイアス		h <sub>FE</sub>	h <sub>FE</sub> h <sub>FE</sub> * (Ω)	h <sub>FE</sub> h <sub>FE</sub> * (×10 <sup>-4</sup> )	h <sub>FE</sub> h <sub>FE</sub> * (μS)	f <sub>αB</sub> f <sub>r</sub> * (Mc)		
1	2	3	4	5					6		7		8				9	10	11	12

- 1 TYPE NUMBER
- 2 ORIGINAL MANUFACTURER
- 3 USES
- 4 MATERIAL AND STRUCTURE
- 5 MAXIMUM RATINGS
- 6 I<sub>CBO</sub> MAXIMUM VALUE AND V<sub>CB</sub> VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I<sub>CBO</sub>)
- 7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h<sub>FE</sub> AND V<sub>CE</sub>, I<sub>C</sub> (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h<sub>FE</sub>)
- 8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V<sub>CB</sub>, I<sub>E</sub> (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

- \* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.
  - 9 f<sub>αB</sub> OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF \* WHICH INDICATES VALUE OF f<sub>r</sub>.
  - 10 C<sub>ob</sub> AND r<sub>bb'</sub> OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF \* IN r<sub>bb'</sub> COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h<sub>ie</sub> (real)
  - 11 OUTLINE
  - 12 REMARKS
- :とコンプリ: COMPLEMENTARY TO .....

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T <sub>a</sub> = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T <sub>a</sub> = 25°C)										外形	備考				
				V <sub>CB0</sub> (V)	V <sub>EB0</sub> (V)	I <sub>C</sub> (mA)	P <sub>C</sub> (mW)	T <sub>J</sub> (°C)	I <sub>CB0</sub> 最大値		直流又はパルス h <sub>FE</sub>		バイアス		h <sub>je</sub> h <sub>je</sub> * (μs)	h <sub>ie</sub> h <sub>ie</sub> * (Ω)	h <sub>re</sub> h <sub>re</sub> * (×10 <sup>-4</sup> )	h <sub>oe</sub> h <sub>oe</sub> * (μΩ)			f <sub>αB</sub> f <sub>T</sub> * (Mc)	C <sub>ob</sub> (pF)	r <sub>bb'</sub> h <sub>ie(recl)</sub> * (Ω)	
									μA	V <sub>CB</sub> (V)	I <sub>C</sub> (mA)	V <sub>CE</sub> (V)	I <sub>C</sub> (mA)	V <sub>CE</sub> (V)										I <sub>E</sub> (mA)
2SB751	松下	PA.SW	Si.EP	-60	-5	-4A	40W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-200	-60	1000- 10000	-3	-3A									268	ターレット	
" 752																								
" 753	東芝	SW.PA	Si.T	-100	-5	-7A	40W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-5	-100												268	2SD843 とコンプリ	
" 754	"	"	"	-50	-5	-7A	60W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-10	-50											10*	250	2SD844 とコンプリ	
" 755	"	PA	"	-150	-5	-12A	120W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-50	-150											10*	300	2SD845 とコンプリ	
" 756																								
" 757	富士電機	SW.PA	Si.EP	-40	-5	-15A	80W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-10	-40													220	2SD847 とコンプリ
" 758	日電	PA	Si.T	-120	-5	-7A	80W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-50	-110													295	
" 759	松下	AF.RF	Si.EP	-25	-5	-50	250	125	-1	-10													276	
" 760	"	PA	"	-60	-5	-1A	30W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-200	-60													268	
" 761	"	"	"	-60	-5	-3A	35W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-200	-60													268	
" 762	"	"	"	-60	-5	-4A	40W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-400	-60													268	
" 763	"	"	"	-60	-5	-5A	60W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-400	-60													152	
" 764	三洋	AF.PA	Si.EP	-60	-5	-1A	900	150	-1	-50											150*	20	294	2SD863 とコンプリ
" 765	日立	SW	Si.TP	-120	-7	-3A	30W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-100	-120													268	ターレット
" 766	松下	PA	Si.EP	-30	-5	-1A	500	125	-0.1	-20											200*	20	336	2SD874 とコンプリ
" 767	"	"	"	-80	-5	-500	500	125	-0.1	-20											120*	20	336	2SD875 とコンプリ
" 768	日電	"	Si.T	-200	-5	-2A	20W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-50	-150											10*		185	2SD1033 とコンプリ
" 769																								
" 770																								
" 771																								
" 772	日電	PA.SW	Si.E	-40	-5	-3A	10W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-1	-30											80*	55	225	2SD882 とコンプリ
" 773	"	PA	Si.T	-100	-5	-6A	70W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-50	-90													295	
" 774	松下	AF	Si.EP	-30	-15	-100	250	125	-1	-10											150*	4	138	
" 775	三洋	PA.SW	Si.P	-100	-6	-6A	60W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-100	-40											13*	150	155	2SD895 とコンプリ
" 776	"	"	"	-120	-6	-7A	70W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	-100	-80											15*	200	155	2SD896 とコンプリ
" 777																								
" 778																								
" 779	松下	AF	Si.EP	-25	-7	-500	200	125	-0.1	-25											150*	15	176	2SD813 とコンプリ
" 780	"	"	"	-30	-5	-500	400	125	-0.1	-20											200*	6	276	